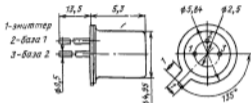


2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г, КТ117А, КТ117Б, КТ117В, КТ117Г

Транзисторы кремниевые выпарные однопереходные с n-ба-
зой

Предназначены для работы в маломощных генераторах
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выво-
дами. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 0,45 г



Электрические параметры

| Коэффициент передачи напряжения при $U_{Б1Б2} = 10$ В | |
|--|-----------|
| при $T = 298$ К | |
| 2Т117А, 2Т117В, КТ117А, КТ117В | 0,5—0,7 |
| 2Т117Б, 2Т117Г | 0,65—0,85 |
| КТ117Б, КТ117Г | 0,65—0,90 |
| при $T = 343$ К | |
| 2Т117А, 2Т117В, КТ117А, КТ117В | 0,45—0,7 |
| 2Т117Б | 0,6—0,85 |
| 2Т117Г | 0,6—0,8 |
| КТ117Б, КТ117Г | 0,6—0,9 |
| при $T = 213$ К | |
| 2Т117А, 2Т117В, КТ117А, КТ117В | 0,5—0,8 |
| 2Т117Б, 2Т117Г | 0,65—0,9 |
| КТ117Б, КТ117Г | 0,65—0,95 |
| Ток включения эмиттера при $U_{Б1Б2} = 10$ В не бо- лее | 20 мкА |
| Ток выключения эмиттера при $U_{Б1Б2} = 20$ В не ме- нее | 1 мА |
| Остаточное напряжение эмиттер-база не более | |
| при $T = 213 - 298$ К | 5 В |
| при $T = 343$ К, $I_3 = 10$ мА 2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г | 4 В |
| при $T = 343$ К, $I_3 = 50$ мА КТ117А, КТ117Б, КТ117В, КТ117Г | 4 В |

Межбазовое сопротивление:

при $T = 298 \text{ K}$:

| | |
|--------------------------|-----------|
| 2Т117А, 2Т117Б | 4–7,5 кОм |
| 2Т117В, 2Т117Г | 6–9 кОм |
| КТ117А, КТ117Б | 4–9 кОм |
| КТ117В, КТ117Г | 8–12 кОм |

при $T = 343 \text{ K}$:

| | |
|--------------------------|----------|
| 2Т117В, 2Т117Г | 6–15 кОм |
| КТ117В, КТ117Г | 6–18 кОм |

при $T = 213 \text{ K}$:

| | |
|--------------------------|-----------|
| 2Т117В, 2Т117Г | 3–8,5 кОм |
| КТ117В, КТ117Г | 4–12 кОм |

Температурный коэффициент межбазового сопротивления 0,1–0,9 %/K

Наибольшая частота генерации 200 кГц

Обратный ток эмиттера при $U_{Б1Б2} = 30 \text{ В}$ не более:

| | |
|-----------------------------------|--------|
| при $T = 298 \text{ K}$ | 1 мкА |
| при $T = 398 \text{ K}$ | 10 мкА |

Ток модуляции не менее 10 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное межбазовое напряжение 30 В

Постоянное напряжение база-эмиттер 30 В

Постоянный ток эмиттера 50 мА

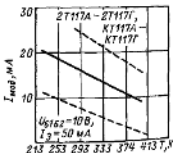
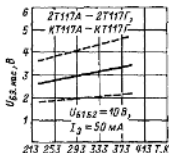
Импульсный ток эмиттера при $\tau_n < 10 \text{ мкс}$, $Q > 200$ 1 А

Постоянная рассеиваемая мощность эмиттера:

| | |
|---|---------|
| при $T = 213 + 308 \text{ K}$ | 300 мВт |
| при $T = 398 \text{ K}$ | 15 мВт |

Температура перехода 403 К

Температура окружающей среды От 213 до 398 К



Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения база-эмиттер от температуры.

Зона возможных положений зависимости тока модуляции от температуры.